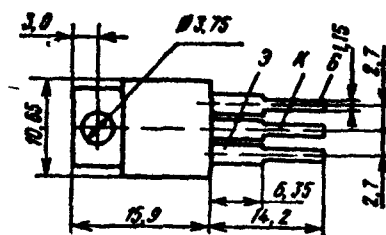
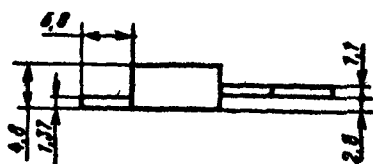


КТ712 (А, Б)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* составные усилительные. Предназначены для применения в источниках вторичного электропитания и стабилизаторах напряжения. Корпус пластмассовый с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2,5 г.

КТ712 (А, Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КВ}=5 В, I_B=2 А$:

$T = +25 °C$:		
КТ712А	500..1500..10000	
КТ712Б	400..1500..10000	
$T = +100 °C$:		
КТ712А, не менее	500	
КТ712Б, не менее	400	
$T = -45 °C$:		
КТ712А, не менее	100	
КТ712Б, не менее	100	

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КВ}=5 В, I_B=0,5 А$, не менее 3 МГц

Граничное напряжение при $I_K=0,05 А$, не менее:
 КТ712А 160 В
 КТ712Б 150 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=2 А, I_B=0,01 А$ 0,9*...1,3*...2 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=2 А, I_B=0,01 А$ 0,8*...1,5*...3 В

Пробивное напряжение коллектор — база при $U_{КВ}=1 мА$, не менее:

КТ712А	200 В
КТ712Б	160 В

Обратный ток эмиттера при $U_{ВЭ}=5 В$, не более:
 типное значение 5 мА
 2* мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:
 КТ712А 200 В
 КТ712Б 160 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{э} \leq \leq 100 Ом$.
 КТ712А 200 В
 КТ712Б 160 В

Постоянное напряжение база — эмиттер 5 В

Постоянный ток коллектора 10 А

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 10 мс, Q \geq 2$ 15 А

Постоянный ток базы 0,1 А

Импульсный ток базы при $t_u \leq 10 мс, Q \geq 2$ 0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -45...+25 °C$:

с теплоотводом ¹	50 Вт
без теплоотвода ²	1,5 Вт

Температура *p-n* перехода +150 °C

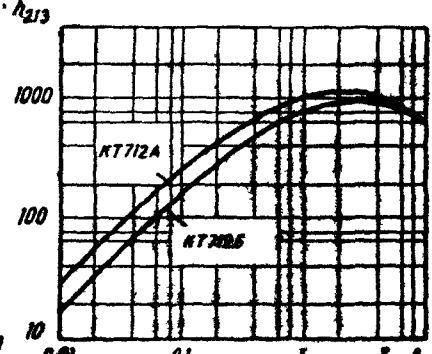
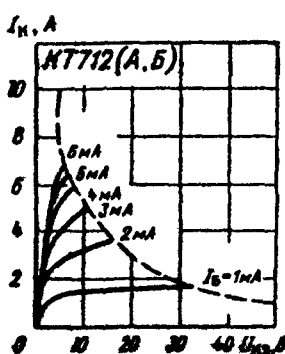
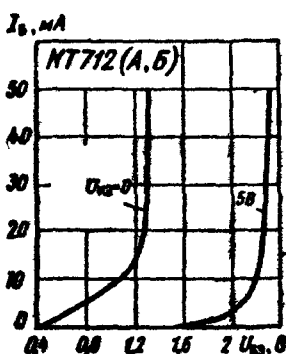
Температура окружающей среды -45 °C... $T_K = +100 °C$

¹ При $T_K = +25...+100 °C$ $P_{К, макс}$ уменьшается линейно до 20 Вт.

² При $T_K = +25...+100 °C$ $P_{К, макс}$ уменьшается линейно до 0,6 Вт.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В.

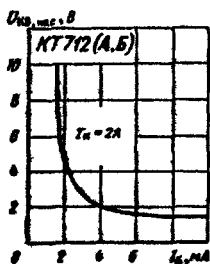
Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса при температуре припоя +265 °C в течение не более 3 с. Допускается не более трех перепаяк. Разрешается осуществлять пайку путем погружения выводов в припой с температурой +250 °C на время не более 5 с, допускается пайка волной припоя при температуре +240 °C.



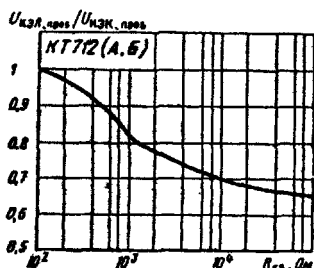
Входные характеристики

Выходные характеристики

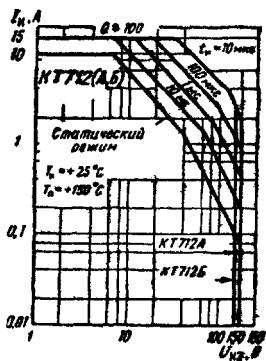
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



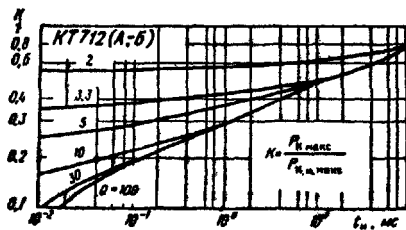
Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока базы



Зависимость пробивного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Область максимальных режимов



Зависимость коэффициента K от длительности импульса